实验名称: 中子活化后放射性核素半衰期测量

实验人员: 朱天宇 学号: 202211010110

实验目的

1. 掌握中等寿命的放射性核素半衰期(天、时、分、秒数量级)的测定方法。

- 2. 了解产生人工放射性核素的基本知识。
- 3. 学会使用多功能数字多道的多定标功能

实验原理

1、半衰期的测定

半衰期是放射性原子核的一条重要的基本性质,每种核素都有它特有的半衰期,因此测定半衰期和测定原子核质量一样,可以用于鉴别原子核。半衰期对研究放射性原子核有重要意义,由半衰期可以确定跃迁级次或多级性。在生产和应用放射性核素时,也需要了解其半衰期对放射性生长或衰变的关系,才能适当的掌握照射时间和不失时机的使用放射性核素。

不同放射性核素半衰期差别很大(从 10^{-11} 秒到 10^{11} 年),不同范围的半衰期测量方法各不相同。ms 以下的短半衰期用核电子学的延迟符合等方法测量。10年以上的长半衰期用比放射性的方法测量。中等半衰期则可以通过测量衰变曲线求得,本实验测量 ^{116m}In 的半衰期就是这一范围的放射性核素半衰期。对于单一放射性核素,仪器得到的计数率随时间的变化为

$$n(t) = n(0)e^{-\lambda t}$$

n(0)(或 n_0)为开始测量时的计数率, n(t)为开始测量后 t 时刻的计数率, λ 为衰变常数,

衰变常数和半衰期 $T_{1/2}$ 的关系为

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

由计数率的指数衰变规律可得

$$lnn(t) = lnn(0) - \lambda t$$

计数率的对数和时间满足直线关系,用目测作图或者最小二乘法拟合直线可得 λ ,再算得 $T_{1/2}$ 。

由于实际上不能测到 t 时刻的计数率 n(t),测到的只能是某一时间间隔 $\Delta t = t2 - t1$ 的计数N,再由 $N/\Delta t$ 求得平均计数率 $ar{n}$.

2、生产放射性核素的一般知识

将稳定核素 A 放在带电粒子或者中子流中辐照,产生核反应

$$A + a \rightarrow B + b$$

剩余核素 B 可能是放射性的。若剩余核素的衰变常数为 λ ,则在恒定的入射粒子通量 ϕ 下,放射性核素 B 活度 A(t)按

$$A(t) = \phi \sigma N_1 (1 - e^{-\lambda t})$$

规律生长,其中 σ 是该反应的反应截面(称为活化截面), N_1 为样品中稳定核素A的总数,A(t)为饱和活度,表 1 给出了产生的活度和辐照时间 t 的关系。可以根据生产核素的半衰期和辐照条件权衡确定辐照时间。

表1:

| $t=nT_{1/2}$ | $0.5T_{1/2}$ | $1T_{1/2}$ | $2T_{1/2}$ | $3T_{1/2}$ | $4T_{1/2}$ | $5T_{1/2}$ | $6T_{1/2}$ |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $A(t)/A(\infty)$ | 0.293 | 0.5 | 0.75 | 0.875 | 0.938 | 0.969 | 0.985 |

天然铟的同位素丰富度及活化反应有关的数据列于表2。当被激活样品中存在两种独立的放射性核素时,衰变曲线上的计数率是两种放射性核素的计数率 之和

$$n(t) = n_1(t) + n_2(t) = n_1(0)e^{-\lambda_1 t} + n_2(0)e^{-\lambda_2 t}$$

由总衰变曲线定出较长半衰期 $(T_{1/2})_1$,然后从n(t)中扣除 $n_2(t)$,求出 $n_1(t)$,再得到 $(T_{1/2})_2$ 。铟活化后生成五种放射性核素和同质异能素,由于同质异能素 $1^{16m}In$ 的半衰期和其他四种放射性核素半衰期相差 1-2 个数量级以上,适当选择活化辐照时间和"冷却时间"(即从停止辐照到开始测量活性的时间),可以使其它四种放射性对 $1^{16m}In$ 半衰期测量的影响很小,故而可以用单一放射性半衰期的规律处理数据。

表2:

| 同位素丰度 | $^{113}In4.28\%$ | | $^{115}In95.72\%$ | | |
|---------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| 活化后剩余核素 | ^{114}In | ^{114m}In | ^{116}In | ^{116m}In | ^{116}In |
| 热中子活化截面 | 3.9b | 4.4b | 45b | 65b | 92b |
| 剩余核半衰期 | 71.9s | 50d | 14.2s | 54.1min | 2.16s |

实验内容

- 1.测量本底
- 2.根据时间道宽 Δt 内统计误差(与活化片的活化相关)的要求,选取每道时

间道宽 Δt

首先 Δt 要满足

 $\Delta t \lambda << 1$

即: $\Delta t << T_{1/2}$

 $T_{1/2}=54min$ 很容易满足

其次满足

 $0.0289 imes \Delta t imes (rac{\Delta t}{T_{1/2}}) << (t_1+t_2)/2$

其中, t_1+t_2 取最小时 $t1=0,t2=\Delta t$

则 $\Delta t << T_{1/2}/0.0578$ 也容易满足

本实验取 $\Delta t = 0.5s$ 、1s

3.选择合适活化时间的源,进行测量

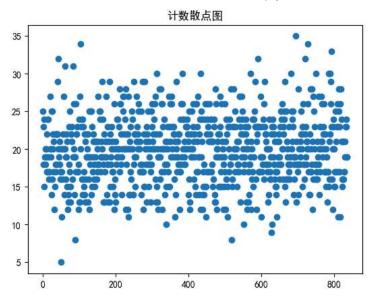
考虑的时间限制,我们仅对样品进行半个半衰期时间的活化。

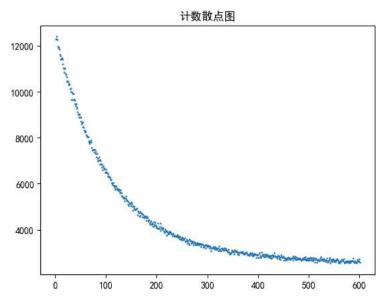
4.测量本底

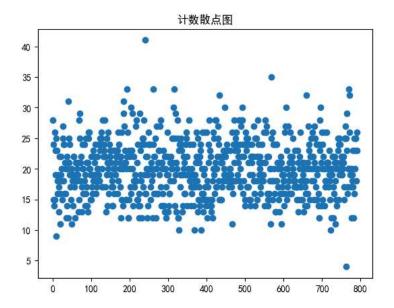
实验数据处理

绘图与计算均使用python

1.根据数据分别画出本底1、样本、本底2的计数散点图(x-y轴分布为计数次数、计数数量,每次计数时间为1s)

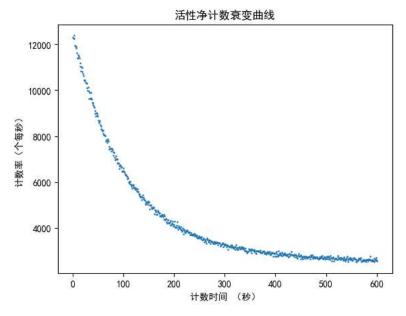




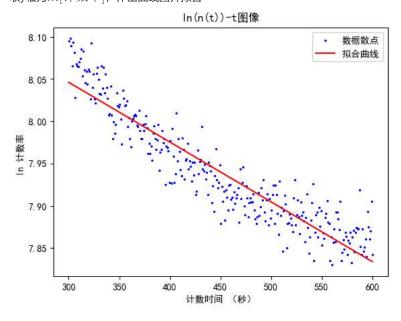


可见没有明显的过高的计数,故不删除数据 2.统计两个本底的数据,计算出本底平均计数率为 $ar{n}_b=19.94s^{-1}$

扣除本底后,取1秒内计数作中间时间的计数率,活性净计数衰变曲线为



3.考虑到 ^{116m}In 与其它同位素的半衰期,应取300s后的数据进行计算,此时,大多核素经过数个半衰期,含量已经很小。取y轴为ln[计数率],作出曲线图并拟合



得出直线斜率 $k=-7.06777953\times 10^{-4}$

由 $lnn(t) = lnn(0) - \lambda t$ 可得

 $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = -\frac{\ln 2}{k} = 980.71s = 16.34min$

实际上,数据中为多种核素辐射产生的,应取拟合函数

 $f(t) = A_1 e^{-B_1 t} + A_2 e^{-B_2 t}$

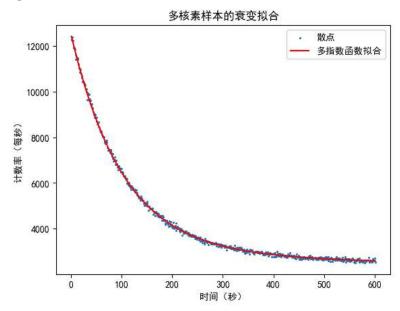
拟合结果为

 $A_1 = 9566.36120 \pm 29.1914443$

 $B_1 = 9.75454995 \times 10^{-3} \pm 5.77525518 \times 10^{-5}$

 $A_2 = 2898.27171 \pm 33.03078$

 $B_2 = 2.03356026 \times 10^{-4} \pm 2.22689093 \times 10^{-5}$



计算出半衰期为

$$T_{1/2} \pm \Delta T_{1/2} = rac{ln2}{B_2} \pm (-rac{ln2}{B_2^2}\sigma_{B_2}) = 56.80 \pm 6.22 (min)$$

思考题

1.总活化时间为162.3min, 冷却10min

由: $A(t)=\phi\sigma N_1(1-e^{-\lambda t})$ 计算,对同一样本, N_1,ϕ 相同,且 σ 可通过查**表2**获得

| 核素 | $^{116m}In(65b)$ | ^{116}In | ^{114}In | ^{114m}In | $^{116m}In(92b)$ |
|----|------------------|------------|------------|-------------|------------------|
| Α | 54.44 | 3.34 | 43.07 | 0.026 | 88.06 |

测量冷却时间为10min,冷却后上面 $^{116m}In(92b)$ 、 ^{114}In 、 ^{116}In 等容易衰变的核素经过数个半周期含量接近零。 $\overline{\mathbb{C}}^{114m}In$ 经过活化后含量仅仅为0.026,远低于 $^{116m}In(65b)$ 的54.44,此时进行测量,可认为计数率仅仅由 $^{116m}In(65b)$ 贡献。

2.去除偏差数据;考虑本底误差;取平均降低误差;最小二乘法拟合降低误差;